

CV  
ამირან ბიბილაშვილი

**პირადი ინფორმაცია:**

1. პ/ნ:01007005441;
2. სქესი: მამრობითი,
3. დაბადების თარიღი: 21.05.1947;
4. მოქალაქეობა: საქართველო,
5. ელ.ფოსტა: [amiran.bibilashvili@tsu.ge](mailto:amiran.bibilashvili@tsu.ge);
6. მობილურის ნომერი: 599 922 186;
7. მისამართი: 0119 თბილისი, ა.წერეთლის გამზ. 97/57

**განათლება:**

1. ფიზ.მათ. მეცნ.დოქტორი (ივ.ჯავახიშვილის სახ. თსუ, 2001წ),
2. ფიზ.მათ. მეცნ.კანდიდატი (მინსკის რადიო-ტექნიკური ინსტიტუტი,1982წ),
3. ფიზიკოსი, მყარი სხეულების ფიზიკა (თსუ, ფიზიკის ფაკულტეტი, 1970 წ).

**აკადემიური ხარისხი:**ფიზ.-მათ.მეცნ.დოქტორი/ მინიჭების თარიღი: 26.12.2001; **აკადემიური წოდება:** პროფესორი, **მინიჭების თარიღი და აკადემიური წოდების მიმნიჭებელი ორგანიზაცია:** 31.05.2004, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

**სამუშაო გამოცდილება:**

1. სსიპ მიკრო და ნანოელექტრონიკის ინსტიტუტი, თბილისი, დირექტორი 2011 წლიდან დღემდე;
2. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნ.ფაკ-ტი, თბილისი, ასოცირებული პროფესორი 2006 წლიდან დღემდე;
3. სსიპ „ტალღა“ უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, თბილისი, 2009-2011წწ;
4. ვაშინგტონის კორპორაცია “ლიქუიდ ლაით ინკ”-ის ფილიალი საქართველოში, დირექტორის მოადგილე, თბილისი, 2007-2011 წწ;
5. თბილისის უნივერსიტეტი „ინტერფამი“: პროფესორი (0,5 სამტ.ერთ); 2006-2009 წწ;
6. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-ს ფიზიკის ფაკ-ტი, პროფესორი, 2002-2006წწ;
7. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-ს ფიზიკის ფაკ-ტი, დოცენტი, 1986-2002 წწ;
8. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-ს ფიზიკის ფაკ-ტი, მიკროელექტრონიკის განყოფილების გამგე, თბილისი, 1983-1986 წწ;
9. სსგ "მიონ"-ი, ელექტრონული მრეწველობის სამინისტრო (სსრკ), რადიაციული კვლევების განყოფილება, ტექნიკოსიდან - უმცრ.მეცნ. თანამშრომ.1970-1983 წწ.

**მეცნიერული ინტერესები:**

1. მიკრო- და ნანოელექტრონიკა;
2. სტიმულირებული პროცესების გამოყენება და მათი არსის შესწავლა მიკრო- და ნანოელექტრონიკულ ტექნოლოგიაში;
3. მიკრო- და ნანოელექტრონული ხელსაწყოების ფიზიკის და მათი მიღების დაბალტემპერატურული ტექნოლოგიების შესწავლა;
4. რადიაციის გავლენა დიელექტრიკების, ნახევარგამტარების, მეტალ-დიელექტრიკ-ნახევარგამტარ სტრუქტურების და მათზე აგებულ ხელსაწყოების პარამეტრებზე;
5. რადიაციით და ფოტონებით სტიმულირებული პროცესები;

**6. არატრადიციული ენერჯის წყაროები.**

**სამეცნიერო პროდუქტიულობა, სტატია/მონოგრაფია/სახელმძღვანელო/პატენტი:**

1. 95 სამეცნიერო სტატია (სამეცნიერო ჟურნალებში Nanomaterials, **J.Vac.Sci.Technol.B, J. Nanotechnology**, IEEE Transactions on Device and Materials Reliability, Earth and Environmental Science, Микроэлектроника, Письма в ЖТФ, Физика и химия обработки материалов, ФТТ, ФТП, Электронная техника, **Nano Studies, Bulletin of the Georgian Academy of Sciences**, Georgian Engineering News, ასევე სამეცნიერო ნაშრომების კრებულებში: New Developments in Material Science, New Science publishers, Inc. New York, "Радиационные дефекты в полупроводниках", изд. БГУ им. Ленина, Минск, და სხვა.

1. 80 საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციებში მონაწილეობა;
2. 6 სახელმძღვანელო - წიგნები (ოსუ-ს გამომცემლობა 2006-2021 წწ).
3. 18 პატენტი (აქედან 4 აშშ, 7 სსრკ და 7 საქართველო „საქპატენტი“).

**პროდუქტიულობის მაჩვენებელი:**

სისტემა	ციტირების ინდექსი	h-ინდექსი
Google Scholar	149.00	6.00
Scopus	65.00	4.00

**სტიპენდიები და ჯილდოები:**

სტიპენდიის/ჯილდოს დასახელება	გამცემი	მიღების წელი
საპატიო სიგელი, ფიზიკის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის	საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია.	2021
ჯილდო მეცნიერებაში მიღწეული წარმატებისათვის	მეცნიერების ისტორიის საქართველოს საზოგადოება	2009

**გრანტები, პროექტები:** 3 საერთაშორისო [ა) ტემპუსი, 2013-2016წწ., უფროსი მეცნიერ თანამშრომ.; ბ) ფირმა „ბორიალის ტექნიკა“ (აშშ), 2005-2006, უფროსი მეცნ.თანამშრ. გ)საერთაშორისო სამეცნ. ტექნოლოგიების ცენტრი, 2.01.2005 -31.12.2005 წწ., მეცნიერ თანამშრომელი] და 6 - შ.რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 1998-2022წწ, სამეცნ.ხელმძღვანელის, ხელმძღვ-ის მოადგილის, მეცნ.თანამშრომ. და მკვლევარის რანგით. ასევე, **მიმდინარე:** შ.რუსთაველის ეროვნ. სამეცნ.ფონდის FR-23-9442, 2.01.4 – 31.12.2026წწ., სამეცნიერო ხელმძღვანელი.

**ენების ცოდნა:** ქართული-მშობლიური, რუსული - სრულყოფილად, გერმანული ლექსიკონის დახმარებით.

**კომპიუტერული ცოდნა:** Word, Exel, Power Point ets. - კარგად.

## CV

### Amiran Bibilashvili

#### Personal information

1. ID Number: 01007005441
2. Gender: Male
3. Date of birth: 21.05.1947
4. Citizenship: საქართველო (Georgia)
5. E-mail address: amiran.bibilashvili@tsu.ge
6. Call number: 599 922 186
7. Tbilisi Address: A.Tsereteli ave.97/57

#### Education:

1. Doctor of Science Phys. and Math. (Iv.Javakhishvili Tbilisi State University საქართველო (Georgia), 2001)
2. Candidat of Science Technical (Institute of Minsk Radio-Technical, 1982)
3. Physicist, Solid State Physics (Tbilisi State University, Department of physics, 1965)  
Professor, 31.05.2004, Iv.Javakhishvili Tbilisi State University, საქართველო (Georgia),

#### Work experience:

1. LEPL of Micro- and Nano Electronics, Tbilisi, Director, from 2011 Until Today;
2. Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Faculty of Exact and Natural Sciences Assoc. Professor, from 2006 Until Today;
3. Research Institute "WAVE", Senior Scientist, Tbilisi, 2009 – 2011;
4. "Liquid Light Inc.", USA. Representative Office in Georgia, Vice-Director, Tbilisi, 2007-2011;
5. Tbilisi University "Interfarm " Full Professor (0,5 staffing unit) 2002 – 2009;
6. Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Department of Physics, Professor, 2002 – 2006;
7. Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Department of Physics, vice-Professor, 1986-2002;
8. Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Department of Physics, Head of Department microelectronics,
9. 1983-1986;
10. Research and Production Association "MION"(Ministry of Electronics Industry, USSR) Department of Radiation Researches, From Technicos – upto Scientist 1970-1983.

#### Research Interests:

1. Micro- and Nanoelectronics;
2. Application of stimulated processes and study of their essence in micro and nanoelectronic technology;
3. Study of the physics of micro- and nanoelectronic devices and low-temperature technologies for their production;
4. Influence of radiation on parameters of dielectrics, semiconductors, metal-dielectric-semiconductor structures and devices based on them;
5. Stimulated processes by radiation and photons;
6. Unconventional Energy Sources.

#### Scientific Productivity:

95 Scientific Articles (in Scientific Journals - Nanomaterials, J.Vac.Sci.Technol.B, J. Nanotechnology, [IEEE Transactions on Device and Materials Reliability](#), Earth and Environmental Science, Physics of the Solid State (Russian), Semiconductor (Russian), Technical Physics Letters (Russian), Phys. Status Solidi, Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, Nano Studies, Physics and chemistry of materials treatment, Georgian Engineering News; as well as, in Collections of Scientific Papers –“New Developments in Material Science, New Science publishers”, Inc. New York, “Radiation defects in Semiconductors” Minsk, and others.

1. 80 Participation in Both International and Local Conferences;
2. 6 Student Textbooks (TSU Publishing House, 2006-2021);
3. 18 Patents (4 – USA, 7 - USSR, 7 – Georgian “Saqpatenti”).

**Productivity index:**

#	Citation index	h-index
Google Scholar	149.00	6.00
Scopus	65.00	4.00

**Scholarships and awards**

Scholarships/awards name	Issuer	Year of Issue
Honorary diploma for scientific achievements in the field of physics.	Georgian national academy of sciences.	2021
Award for Success in Science	Georgian Society of History of Science	2009

**Grants and projects:** 3 International (Tempus 2013- 2016 Senior Researcher; Firm " Borealis Technical" (USA), 2005-2006, Senior Scientist; ISTC 2.01.2005-31.12.2005, Scientist); and 7 Local (from 1998 Until Today). Current - Shota Rustaveli National Science Foundation FR-23-9442, 2.01.2024-31.12.2026, Project head

**Languages:** Georgian – mother, Russian – perfectly, English - with the help of a dictionary

**Computer Skills:** Word, Excel, Power Point etc. -good